



PowerPAK® SO-8S 封装, 150 V, 5.6 mΩ SiRS5700DP MOSFET

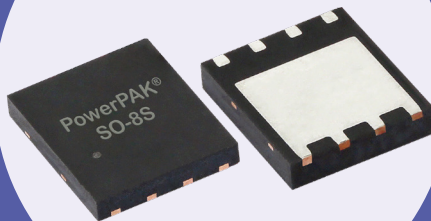
$R_{DS(ON)}$ and $R_{DS(ON)} * Q_g$ FOM 达到业内先进水平, 有助于提高能效

特性

- 典型 $R_{DS(ON)} = 4.6 \text{ m}\Omega$
- $R_{DS(ON)} * Q_g$ FOM 达到业内先进水平
- 符合 IPC-9701 标准, 实现更可靠的温度循环
- 标准 6 mm x 5 mm 占位面积与 PowerPAK® SO-8 封装全面兼容
- PowerPAK® SO-8S (QFN 6x5) packag 封装器件
 - R_{thJC} 极低, 仅为 $0.45 \text{ }^\circ\text{C/W}$, 连续漏极电流可达 144 A, 提高功率密度, 同时具有可靠的 SOA 性能

业界先进的 $R_{DS(ON)}$

PowerPAK® SO-8S



提高功率密度

电路应用

- 同步整流
- DC/DC 转换器
- 电池管理系统
- 电源

终端产品



服务器和边缘计算



超级计算机



数据存储



通信



太阳能逆变器

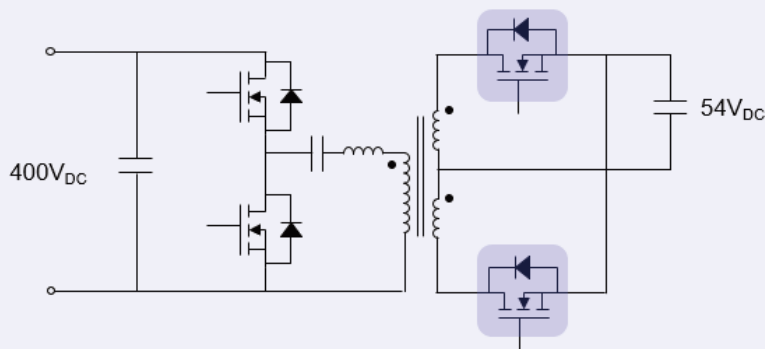


电机驱动



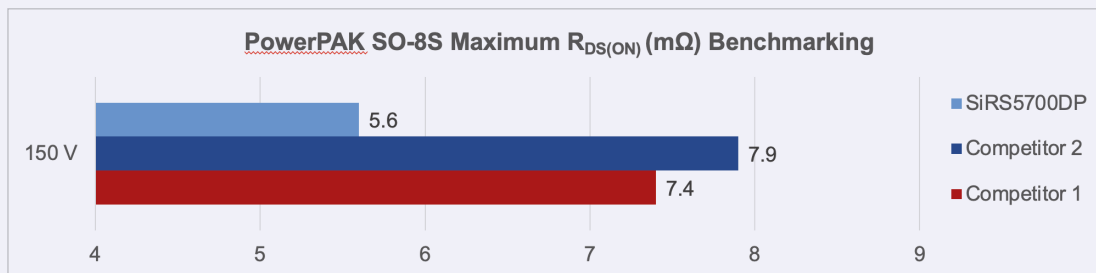
电动工具

典型电路图



SiRS5700DP 用于 54 V_{OUT} 次级侧连接中心抽头变压器的 LLC 谐振转换器

PowerPAK SO-8S Maximum $R_{DS(ON)}$ (mΩ) Benchmarking



与接近的竞品相比, SiRS5700DP 的 $R_{DS(ON)}$ 达到业内先进水平, 至少提高 24.3%, 非常适合满足下一代电源要求, 如 6 kW AI 服务器电源系统。